

ПРОТОКОЛ № 16/2018
Заседания Конкурсной Комиссии
на замещение вакантных должностей научных работников
Федерального государственного автономного научного учреждения
Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники
имени В.Г. Мокерова Российской академии наук

г. Москва

28 августа 2018 г.

Присутствовали:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Председатель комиссии | - доктор технических наук, профессор, директор ИСВЧПЭ РАН С.А. Гамкрелидзе |
| Заместитель председателя комиссии | - кандидат физико-математических наук, доцент заместитель директора по научной работе ИСВЧПЭ РАН Д.С. Пономарев |
| Секретарь комиссии | - кандидат физико-математических наук, ученый секретарь ИСВЧПЭ РАН Р.А. Хабибуллин |
| Члены комиссии: | - кандидат технических наук, председатель Профкома ИСВЧПЭ РАН А.Ю. Павлов |
| | - доктор технических наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе ОАО «НПП «Пульсар» Ю.В. Колковский |
| | - член-корреспондент РАН, врио директора ФТИАН В.Ф. Лукичев |
| | - доктор технических наук, профессор, зам. директора НИИВТ им С.А. Векшинского С.Б. Нестеров |

Всего: 7 человек из 7 членов Конкурсной комиссии.

Повестка дня: Проведение конкурса на замещение вакантной должности научного сотрудника лаборатории № 102 «Лаборатория исследования процессов электронной литографии формирования сверхкороткоканальных нм-транзисторов».

Слушали:

1. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило заявление и комплект документов, необходимых для проведения конкурса от Галиева Рината Радифовича для избрания его на должность научного сотрудника «Лаборатория исследования процессов электронной литографии формирования сверхкороткоканальных нм-транзисторов». Директор зачитал характеристику Галиева Р.Р. подписанную главным конструктором-заместителем директора по НИОКР Федоровым Ю.В. в ней, отмечается что Галиев Р.Р. исследует процессы технологии электронно-лучевой литографии, в том числе затворы применительно к СВЧ-транзисторам мм- и субмм- диапазона частот. Кроме того, Галиев Р. Р. участвует в НИР и ОКР, связанных с использованием электронно-лучевой

литографии для формирования различных функциональных структур критических размеров, например, дифракционных решёток для одномодовых полупроводниковых ЛС-РОС-лазеров.

Галиев Р.Р. является соавтором ноу-хау и патентов, используемых в исследовательской и технологической практике ИСВЧПЭ РАН.

Галиев Р.Р. работает в одном из наиболее приоритетных для России направлений физической науки — разработке физических основ и технологии создания приборов современной гетероструктурной СВЧ-микро и наноэлектроники.

Галиев Р.Р. проявил себя как ответственный и коммуникабельный сотрудник, способный организовать совместную работу с другими сотрудниками как внутри института, так и со сторонними организациями.

Документы удовлетворяют квалификационным характеристикам.

2. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН также поступило резюме для прохождения конкурса от Ханова Мурада 1995 г.р. для избрания по конкурсу на должность научного сотрудника «Лаборатории исследования процессов электронной литографии формирования сверхкороткоканальных нм-транзисторов». Однако документы претендента не удовлетворяют квалификационным характеристикам, предъявляемым по соответствующей должности, а также в комиссию представлен не полный пакет документов, в связи с этим членами Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию претендента Ханова Мурада.

Больше заявок на занятие этой должности в Конкурсную комиссию не поступало.

Постановили:

По 1-му пункту повестки дня:

1) Согласно п. 11 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 в продлении срока рассмотрения заявок для проведения собеседования с претендентом необходимости нет.

2) Признать конкурс на замещение вакантной должности научного сотрудника лаборатории № 102 «Лаборатория исследования процессов электронной литографии формирования сверхкороткоканальных нм-транзисторов» состоявшимся в объявленные сроки.

3) Согласно п. 12 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 по итогам рассмотрения заявки Конкурсная комиссия составила рейтинг претендента на основании бальной оценки, выставленной членами Конкурсной комиссии претенденту, исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке материалах, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента, Конкурсная комиссия приняла решение избрать на должность:

- научного сотрудника «Лаборатории исследования процессов электронной литографии формирования сверхкороткоканальных нм-транзисторов»

– Галиева Рината Раифовича.

Председатель Конкурсной комиссии
д.т.н., профессор
Секретарь Конкурсной комиссии
к.ф.-м.н.



С.А. Гамкрелидзе

Р.А. Хабибуллин

«28» августа 2018 г.